

Виталий Иванович Стафеев

(к 80-летию со дня рождения)



1 января 2009 г. исполняется 80 лет со дня рождения и 55 лет научной деятельности замечательного ученого, заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-математических наук, профессора Виталия Ивановича Стафеева.

Виталий Иванович окончил физико-математический факультет Казахского государственного университета (г. Алма-Ата) в 1952 г. Получив направление в Физико-технический институт АН СССР (г. Ленинград), он оказался в числе тех, кто закладывал основы физики и техники полупроводниковых приборов. Здесь он принял участие в разработке и изготовлении первых высокоточных германиевых выпрямителей. Эти работы, за участие в которых он получил свою первую правительственную награду, заложили основы силовой полупроводниковой электроники в СССР. С первых шагов в науке его характеризовало глубокое понимание физической сущности электронных явлений в полупроводниковых приборах, что привело его к разработке новых принципов их действия, созданию функциональных логических схем и устройств обработки и воспроизведения изображений. Многогранность его природы выразилась в широком охвате различных сторон научно-педагогической и научно-производственной деятельности. В 1964–1969 гг. В.И. Стафеев — директор НИИ Физических проблем им. Ф.В. Лукина (Научный центр

микроэлектроники, г. Зеленоград), с 1969 г. последовательно — заведующий отделом, отделением и главный конструктор направления матричных фотоприемников в НИИ Прикладной физики (ныне ФГУП НПО „Орион“), и с 1965 г. — профессор Московского физико-технического института (МФТИ). Он удостоен звания Почетный работник промышленности вооружений.

Юбиляр внес большой вклад в развитие в нашем отечестве работ по узкощелевым полупроводникам и фотоприемникам инфракрасного диапазона. Под его руководством в этом направлении в течение ряда лет проводились научные симпозиумы и семинары в разных регионах страны, что обеспечило формирование новых научных коллективов в России и странах ближнего зарубежья. Среди его учеников 25 докторов наук. Он автор или соавтор 12 монографий, более 600 научных статей и изобретений. Многие из результатов его исследований вошли в отечественные и зарубежные монографии и учебники.

В.И. Стафеев внес большой вклад в развитие в СССР микроэлектроники — председатель Межведомственного координационного совета по микроэлектронике, организатор и заведующий кафедрой Микроэлектроники в МФТИ, председатель секции „Микроэлектроника“ Совета по физике полупроводников при Президиуме Академии наук СССР.

Научно-производственная деятельность юбиляра отмечена двумя Государственными премиями СССР (1982 г. и 1988 г.) и Государственной премии РФ (2000 г.).

Мы поздравляем Виталия Ивановича со знаменательной датой, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

*Ж.И. Алфёров, А.Л. Асеев, А.А. Гиппиус,
Ю.В. Гуляев, В.И. Иванов-Омский, О.Н. Крохин,
А.А. Каплянский, М.Г. Мильвидский, Ю.К. Пожела,
Я.Е. Покровский, Р.А. Сурис, А.М. Филачев,
редколлегия журнала
«Физика и техника полупроводников»,
коллеги и друзья*